

圖 6-15 P-Well 之形成。

(3) N井之形成：先進行 N-Well 微影，然後植入五價的磷（P）或砷（As），如圖 6-16 所示。最後進行回火（anneal）的步驟，可修補之前植入所引起的損壞（damage）以及使雜質活化（dopant activation）。

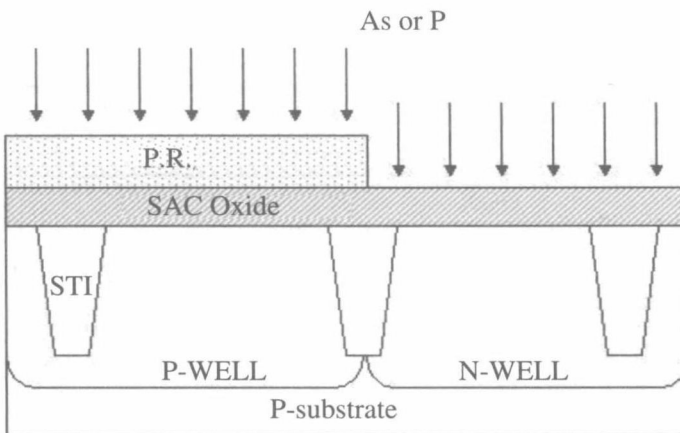


圖 6-16 N-Well 之形成。

### 3. 閘極氧化層（Gate Oxide, GOX）之製程

Gate Oxide 是整個 MOSFET 元件中最重要的心臟部分，其品質好壞會直接影響到 IC 的運作。其製程步驟，首先進行 SAC oxide 之移除，因為之前的植入